

## IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode

### Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
  - $V_{CES} = 4500 \text{ V}$
  - $I_{C \text{ nom}} = 1800 \text{ A} / I_{CRM} = 3600 \text{ A}$
  - Große DC-Festigkeit
  - Hohe dynamische Robustheit
  - Hohe Kurzschlussrobustheit
  - Niedriges  $V_{CESat}$
  - Trench IGBT 4
  - $V_{CESat}$  mit positivem Temperaturkoeffizienten
- Mechanische Eigenschaften
  - Gehäuse mit CTI > 600
  - Standardgehäuse
  - AlSiC Bodenplatte für erhöhte thermische Lastwechselfestigkeit
  - IHM B Gehäuse
  - Isolierte Bodenplatte



Typical appearance

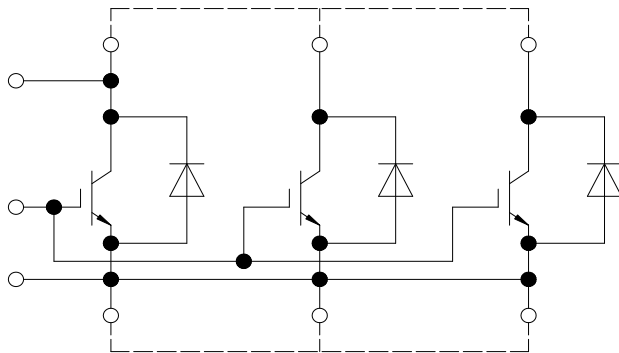
### Potenzielle Anwendungen

- Hochleistungsumrichter
- Mittelspannungsantriebe
- Energieübertragung und -verteilung

### Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

### Beschreibung



external connection  
(to be done)

Inhalt

	<b>Beschreibung</b>	1
	<b>Eigenschaften</b>	1
	<b>Potenzielle Anwendungen</b>	1
	<b>Produktvalidierung</b>	1
	<b>Inhalt</b>	2
1	<b>Gehäuse</b>	3
2	<b>IGBT, Wechselrichter</b>	3
3	<b>Diode, Wechselrichter</b>	5
4	<b>Kennlinien</b>	7
5	<b>Schaltplan</b>	11
6	<b>Gehäuseabmessungen</b>	12
7	<b>Modul-Label-Code</b>	13
	<b>Änderungshistorie</b>	14
	<b>Disclaimer</b>	15

## 1 Gehäuse

**Tabelle 1** Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	$V_{ISOL}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $t = 1 \text{ min}$	6.0	kV
Teilentladungs-Aussetzspannung	$V_{isol}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $Q_{PD} \leq 10 \text{ pC}$	3.5	kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung	$V_{CE(D)}$	$T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$ , 100 Fit	2900	V
Material Modulgrundplatte			AlSiC	
Kriechstrecke	$d_{Creep}$	Kontakt - Kühlkörper	32.2	mm
Luftstrecke	$d_{Clear}$	Kontakt - Kühlkörper	19.1	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	$CTI$		>600	

**Tabelle 2** Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Modulstreuinduktivität	$L_{sCE}$			6		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	$T_C=25^{\circ}\text{C}$ , pro Schalter		0.08		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_C=25^{\circ}\text{C}$ , pro Schalter		0.095		mΩ
Lagertemperatur	$T_{stg}$		-40		150	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	$M$	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M6, Schraube	4.25	5.75	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	$M$	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M4, Schraube	1.8	2.1	Nm
			M8, Schraube	8	10	
Gewicht	$G$			1200		g

## 2 IGBT, Wechselrichter

**Tabelle 3** Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$V_{CES}$		$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C}$	4500	V
			$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	4500	
Kollektor-Dauergleichstrom	$I_{CDC}$	$T_{vj \max} = 150^{\circ}\text{C}$	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	1800	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	$I_{CRM}$	$t_p = 1 \text{ ms}$		3600	A

(wird fortgesetzt...)

**Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Gate-Emitter-Spitzenspannung	$V_{GES}$		$\pm 20$	V

**Tabelle 4 Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 1800\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	2.35	2.80	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	2.85	3.40	
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	2.95	3.50	
Gate-Schwellenspannung	$V_{GEth}$	$I_C = 149\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	5.5	6	6.5	V
Gateladung	$Q_G$	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CE} = 2800\text{ V}$		47		$\mu\text{C}$
Interner Gatewiderstand	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.29		$\Omega$
Eingangskapazität	$C_{ies}$	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		297		nF
Rückwirkungskapazität	$C_{res}$	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		5.4		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	$I_{CES}$	$V_{CE} = 4500\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			5	mA
Gate-Emitter-Reststrom	$I_{GES}$	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{don}$	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.75\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.260		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.290		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.310		
Anstiegszeit (induktive Last)	$t_r$	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.75\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.210		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.230		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.230		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{doff}$	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 4.7\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	6.930		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	7.320		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	7.410		
Fallzeit (induktive Last)	$t_f$	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 4.7\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.130		$\mu\text{s}$
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	2.630		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	2.850		
Einschaltzeit (ohmsche Last)	$t_{on\_R}$	$I_C = 500\text{ A}, V_{CE} = 2000\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.75\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.86		$\mu\text{s}$
Einschaltverlustenergie pro Puls	$E_{on}$	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}, L_\sigma = 110\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.75\text{ }\Omega, di/dt = 6500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ °C})$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	5800		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	8100		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	9100		

(wird fortgesetzt...)

**Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Abschaltverlustenergie pro Puls	$E_{off}$	$I_C = 1800\text{ A}$ , $V_{CE} = 2800\text{ V}$ , $L_\sigma = 110\text{ nH}$ , $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ , $R_{Goff} = 4.7\ \Omega$ , $dv/dt = 1250\text{ V}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$ )		7050		mJ
Kurzschlussverhalten	$I_{SC}$	$V_{GE} = 15\text{ V}$ , $V_{CC} = 3000\text{ V}$ , $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$		8100		A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	$R_{thJC}$	pro IGBT			7.20	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	$R_{thCH}$	pro IGBT, $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(m^{\circ}\text{K})$		3.60		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$		-40		150	$^\circ\text{C}$

### 3 Diode, Wechselrichter

**Tabelle 5 Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	$V_{RRM}$	$T_{vj} = -40\text{ }^\circ\text{C}$	4500	V
		$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	4500	
Dauergleichstrom	$I_F$		1800	A
Periodischer Spitzenstrom	$I_{FRM}$	$t_P = 1\text{ ms}$	3600	A
Grenzlastintegral	$I^2 t$	$t_P = 10\text{ ms}$ , $V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	kA <sup>2</sup> s
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	
Spitzenverlustleistung	$P_{RQM}$	$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	4000	kW
Mindesteinschaltdauer	$t_{onmin}$		10	$\mu\text{s}$

**Tabelle 6 Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	$V_F$	$I_F = 1800\text{ A}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		3.05	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	2.50	2.95	
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	2.45	2.90	
Rückstromspitze	$I_{RM}$	$V_R = 2800\text{ V}$ , $I_F = 1800\text{ A}$ , $V_{GE} = -15\text{ V}$ , $-di_F/dt = 6500\text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$ )	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	2360		A
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	2600		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	2630		

(wird fortgesetzt...)

**Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte**

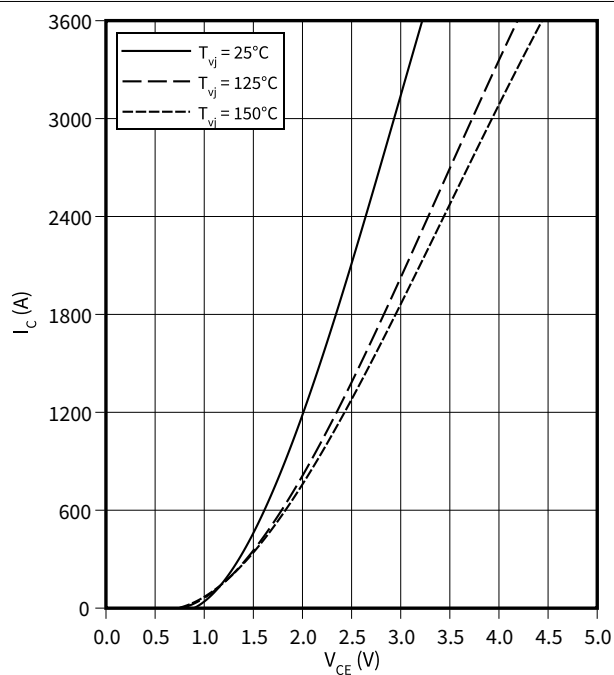
Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Sperrverzögerungsladung	$Q_r$	$V_R = 2800 \text{ V}$ , $I_F = 1800 \text{ A}$ , $V_{GE} = -15 \text{ V}$ , $-di_F/dt = 6500 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$ )	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1560		$\mu\text{C}$
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	3060		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	3560		
Abschaltenergie pro Puls	$E_{rec}$	$V_R = 2800 \text{ V}$ , $I_F = 1800 \text{ A}$ , $V_{GE} = -15 \text{ V}$ , $-di_F/dt = 6500 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$ )	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	2340		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	5200		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	6100		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	$R_{thJC}$	pro Diode			12.7	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	$R_{thCH}$	pro Diode, $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$		5.30		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj op}$		-40		150	$^\circ\text{C}$

## 4 Kennlinien

### Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

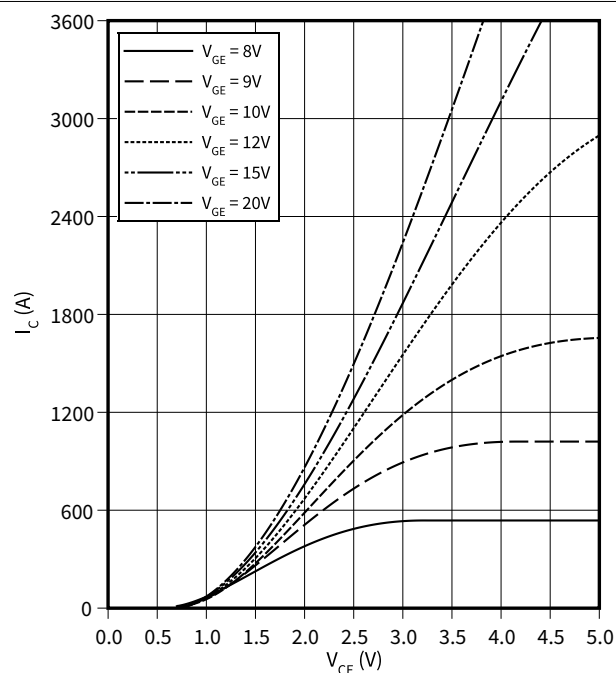
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



### Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

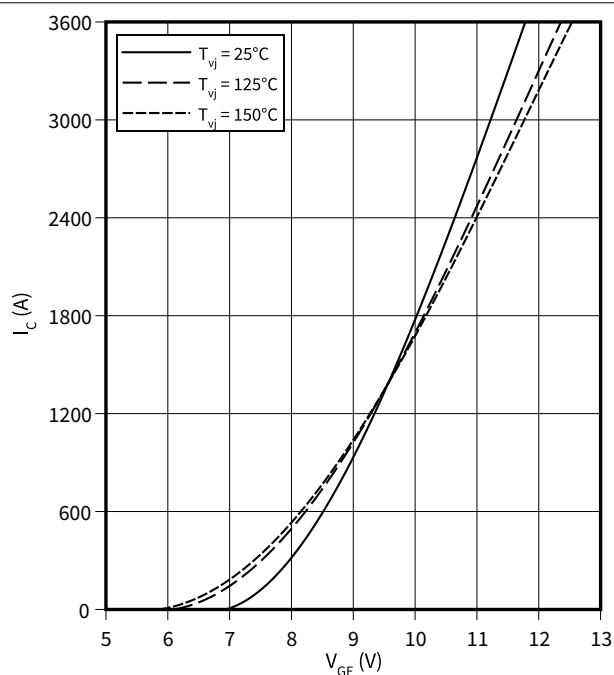
$$T_{vj} = 150 \text{ °C}$$



### Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{GE})$$

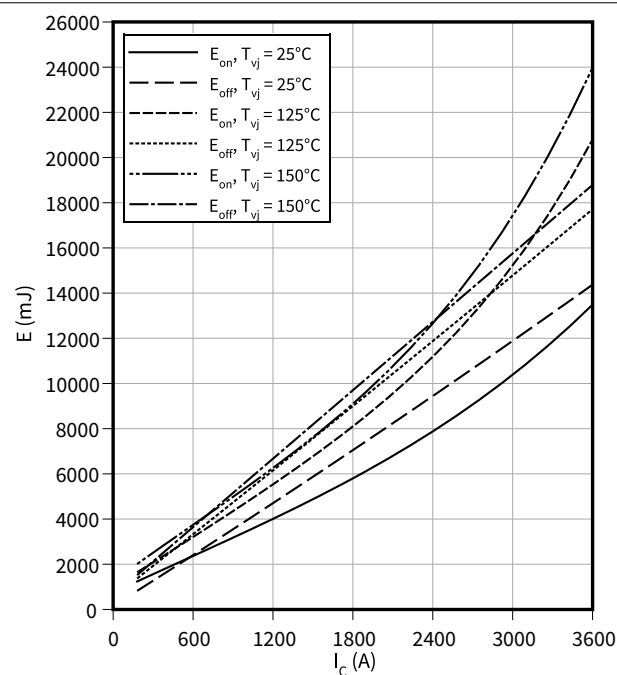
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



### Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

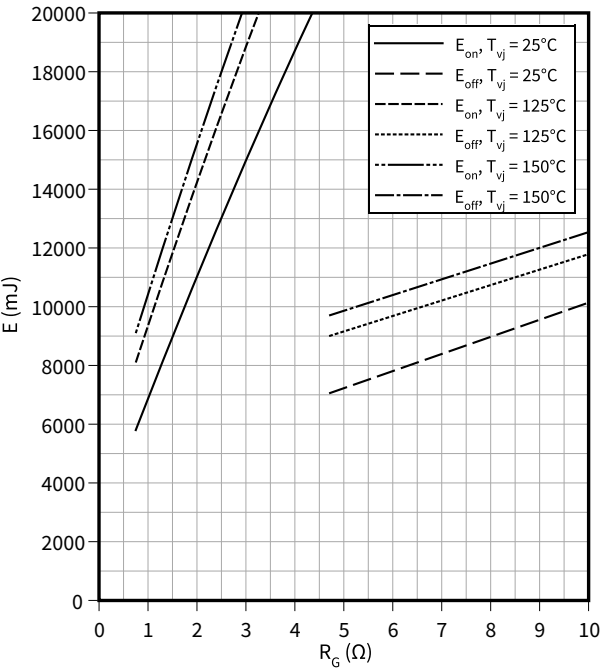
$$E = f(I_C)$$

$$R_{Goff} = 4.7 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 0.75 \text{ } \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CE} = 2800 \text{ V}$$



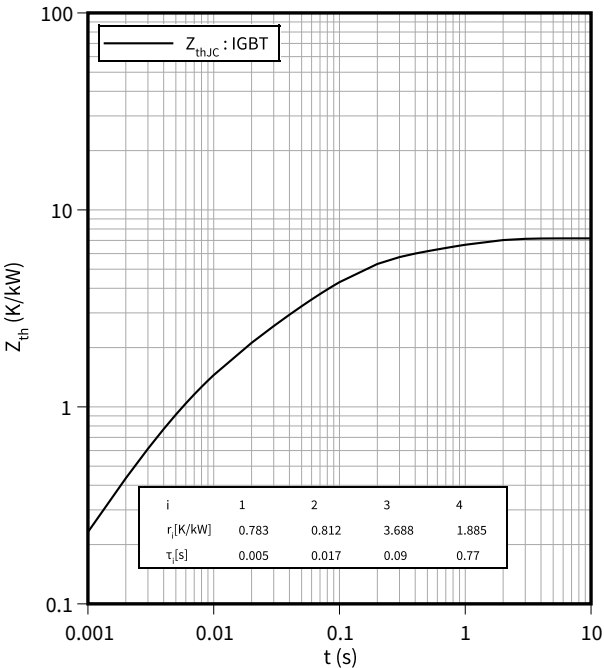
Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 1800\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 2800\text{ V}$



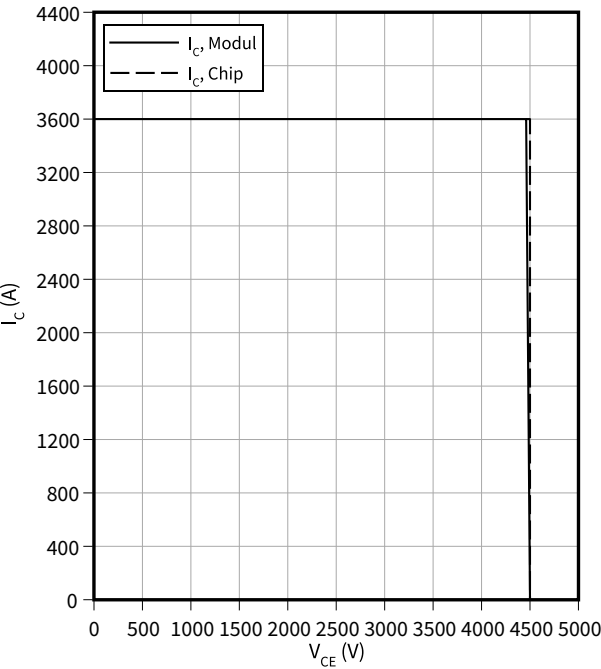
Transienter Wärmewiderstand , IGBT, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



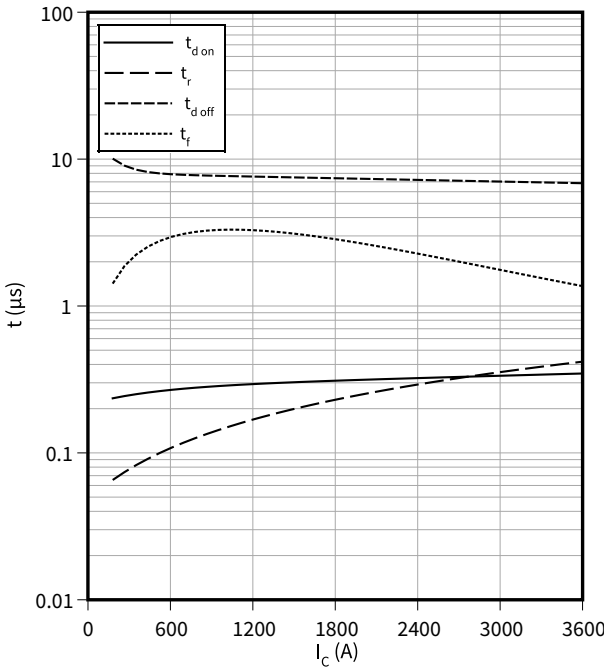
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$   
 $R_{Goff} = 4.7\ \Omega$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $V_{CC} \leq 3000\text{ V}$ ,  $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

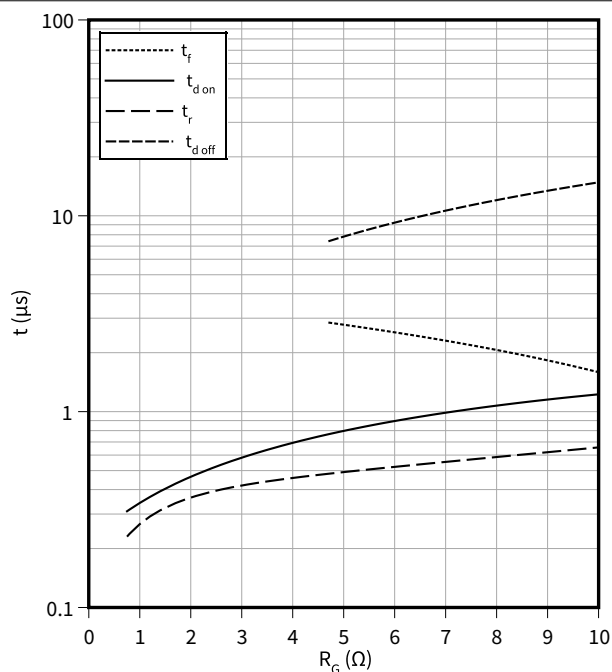
$t = f(I_C)$   
 $V_{CE} = 2800\text{ V}$ ,  $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$ ,  $R_{Goff} = 4.7\ \Omega$ ,  $R_{Gon} = 0.75\ \Omega$ ,  $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$



**Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter**

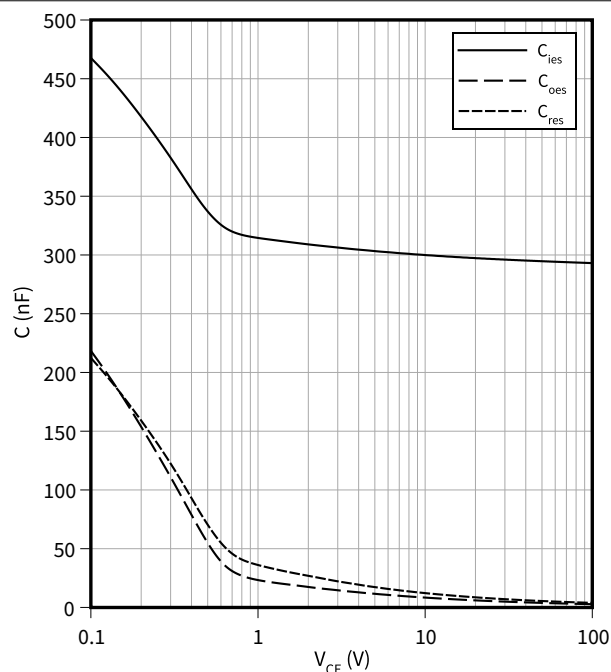
$$t = f(R_G)$$

$$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 1800 \text{ A}, V_{CE} = 2800 \text{ V}, T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$$

**Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter**

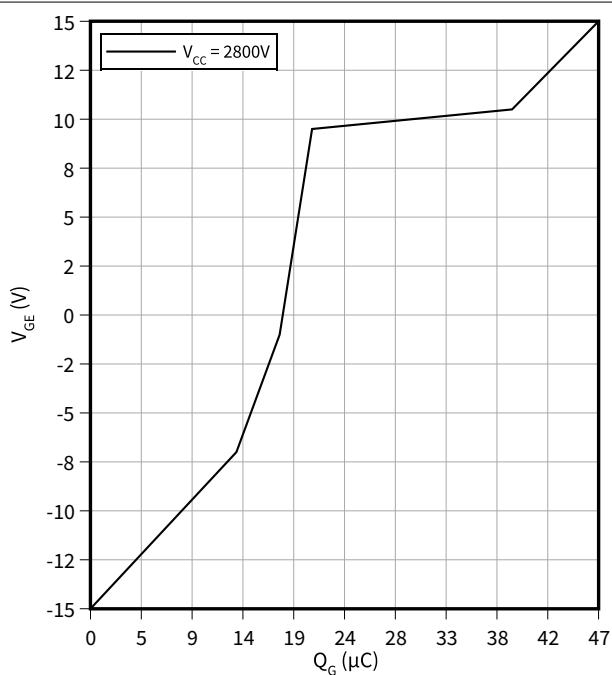
$$C = f(V_{CE})$$

$$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$$

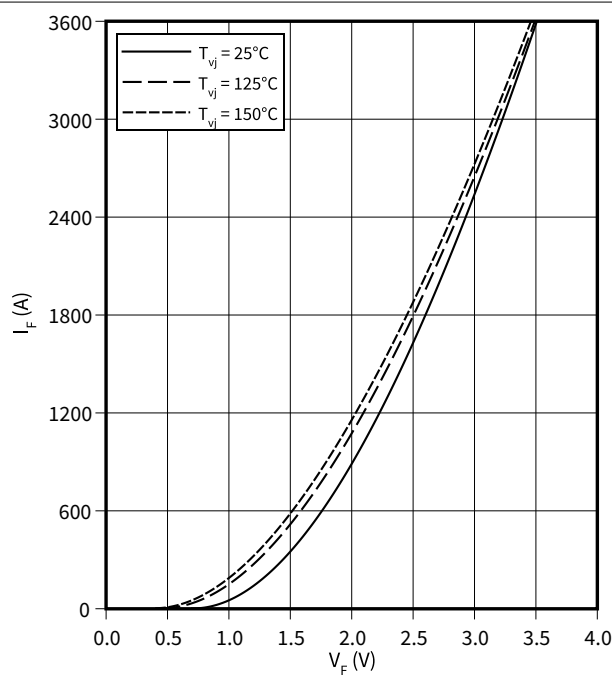
**Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter**

$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$$I_C = 1800 \text{ A}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$$

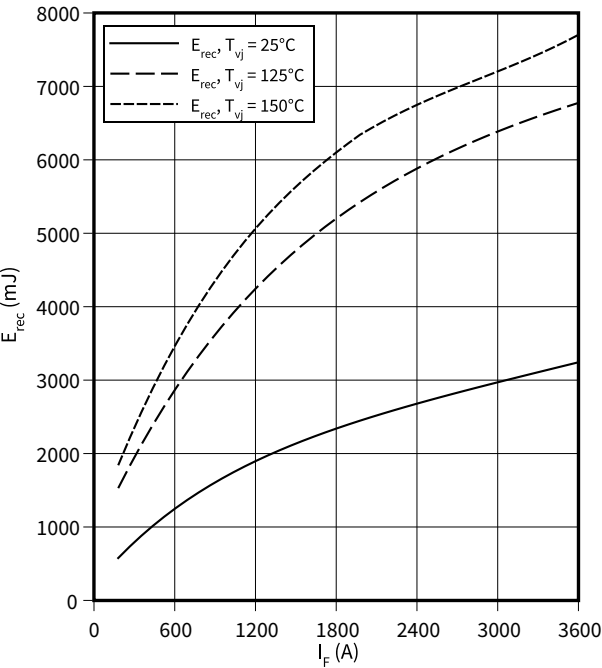
**Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Wechselrichter**

$$I_F = f(V_F)$$



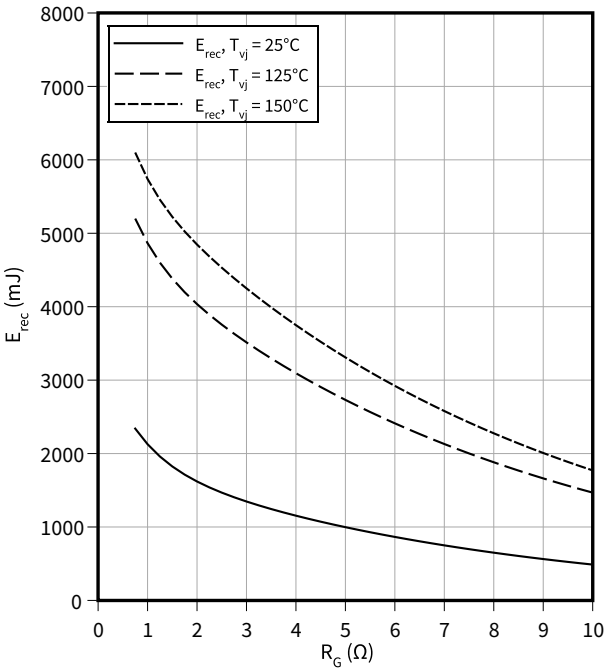
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$   
 $V_{CE} = 2800\text{ V}, R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$



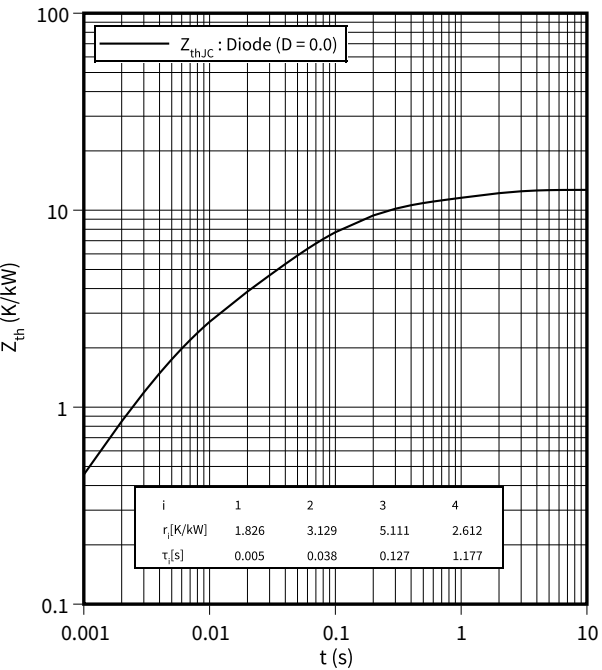
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(R_G)$   
 $V_{CE} = 2800\text{ V}, I_F = 1800\text{ A}$



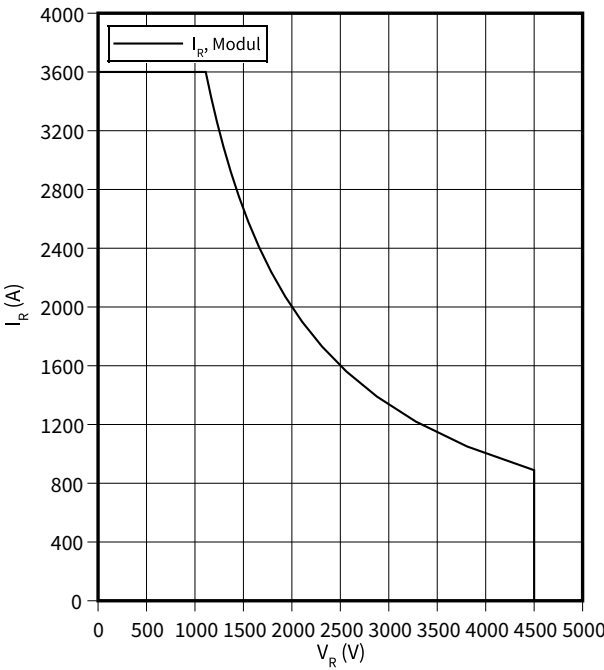
Transienter Wärmewiderstand , Diode, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$

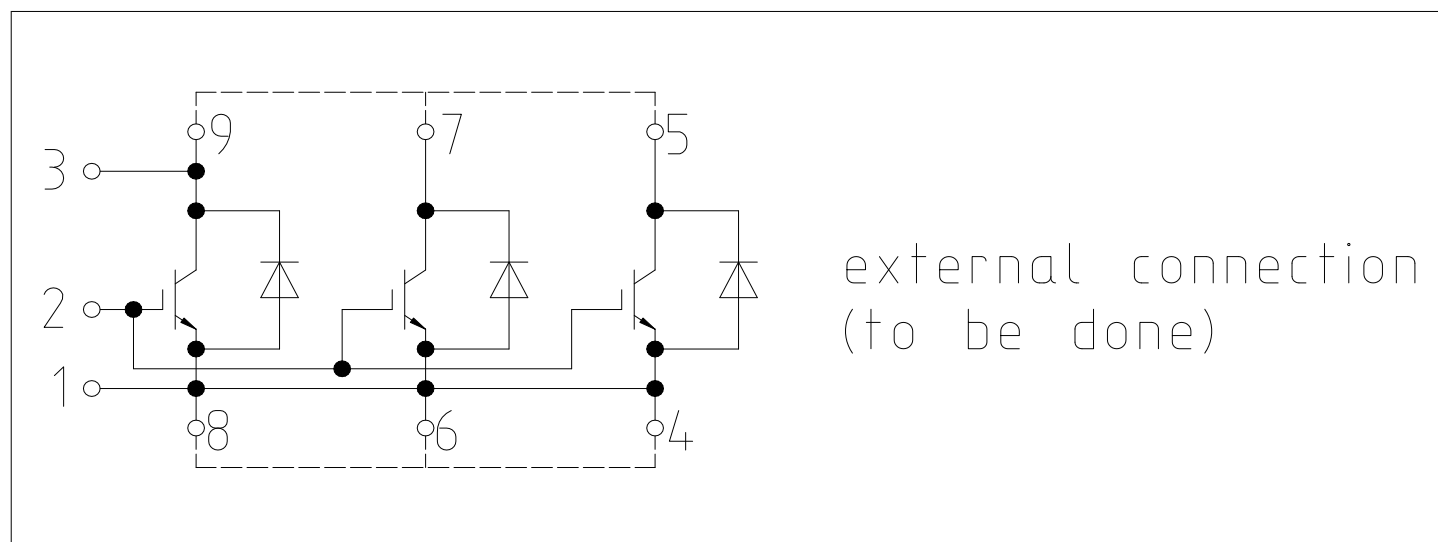


Sicherer Arbeitsbereich (SOA), Diode, Wechselrichter

$I_R = f(V_R)$   
 $T_{vj} = 150\text{ °C}$



## 5 Schaltplan



**Abbildung 1**

## 6



7 Modul-Label-Code



Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	<div> 71549142846550549911530</div> <div> 71549142846550549911530</div>		

Abbildung 3

## Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2020-09-18	
0.10	2020-10-05	
0.20	2021-03-25	
1.00	2021-04-16	Final
1.10	2021-10-20	Final datasheet
1.20	2021-10-26	Final datasheet

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**Edition 2021-10-26**

**Published by**

**Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2021 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any  
aspect of this document?**

**Email: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)**

**Document reference  
IFX-AAK623-006**

## WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht gemäß den AEC Q100 oder AEC Q101 Dokumenten des Automotive Electronics Council qualifiziert ist.

## WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.